

SuperKEKB-LER 陽電子用ダンピングリング 入出射路の コミッショニング

2018.8.9

第15回加速器学会

高エネルギー加速器研究機構 (KEK)

飯田 直子

for SuperKEKB and LINAC Commissioning Group

ダンピング・リング (DR) : SuperKEKB-LERに入射するための e^+ ビームの
エミッタンスを小さくする

目次

0. DR

1. The DR Complex

- Positron Damping Ring(DR)
- Linac To Ring(LTR) : DRへの入射路
- Ring To Linac(RTL) : DRからの出射路

2. LTRのコミッショニング

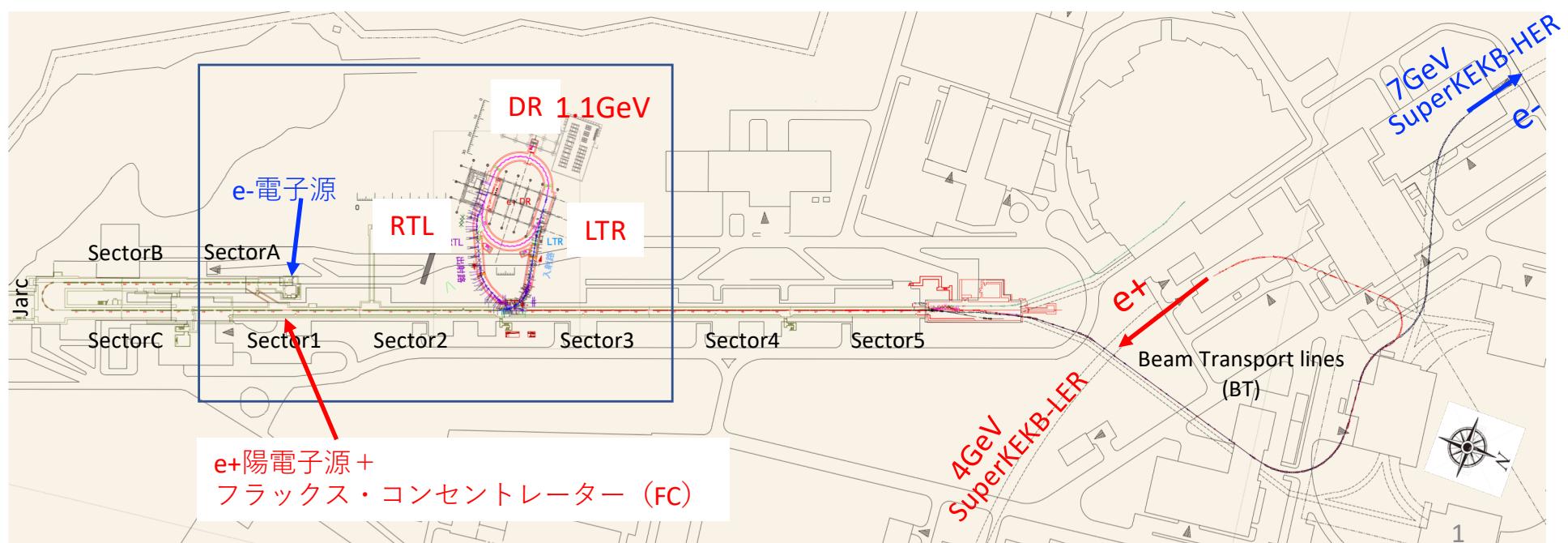
3. RTLのコミッショニング

4. まとめ

WEOLP01, Y. Ohnishi, 他

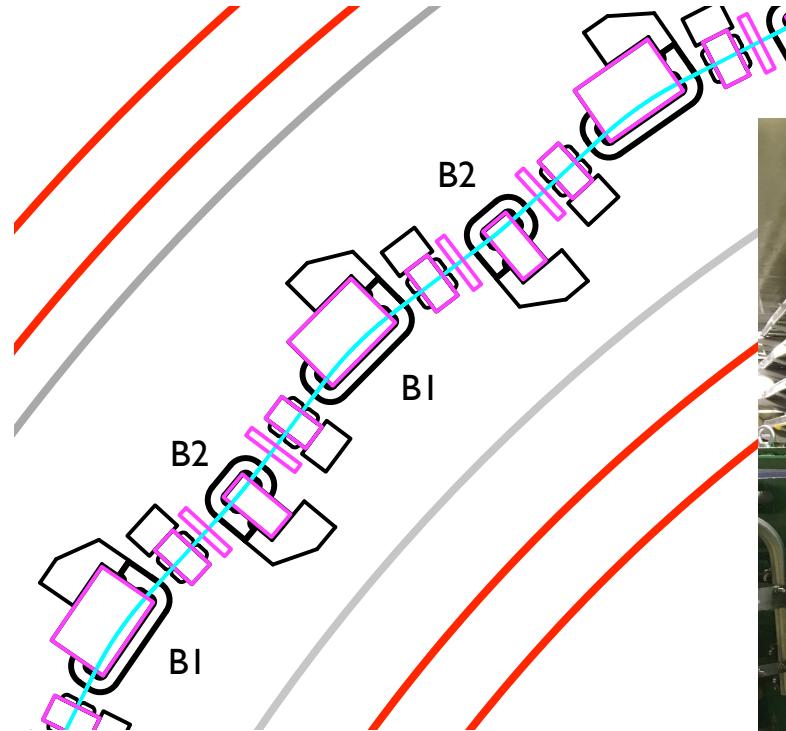
SuperKEKB-LERから 入射ビームへの要求値

	Phase 2	Phase3 -
	2018年	2019年～
$\gamma\epsilon_x$ [μm]	< 200	< 100
$\gamma\epsilon_y$ [μm]	< 40	< 15
$\sigma\delta$ [%]	0.16	0.1
電荷量 [nC]	1.5	4.0



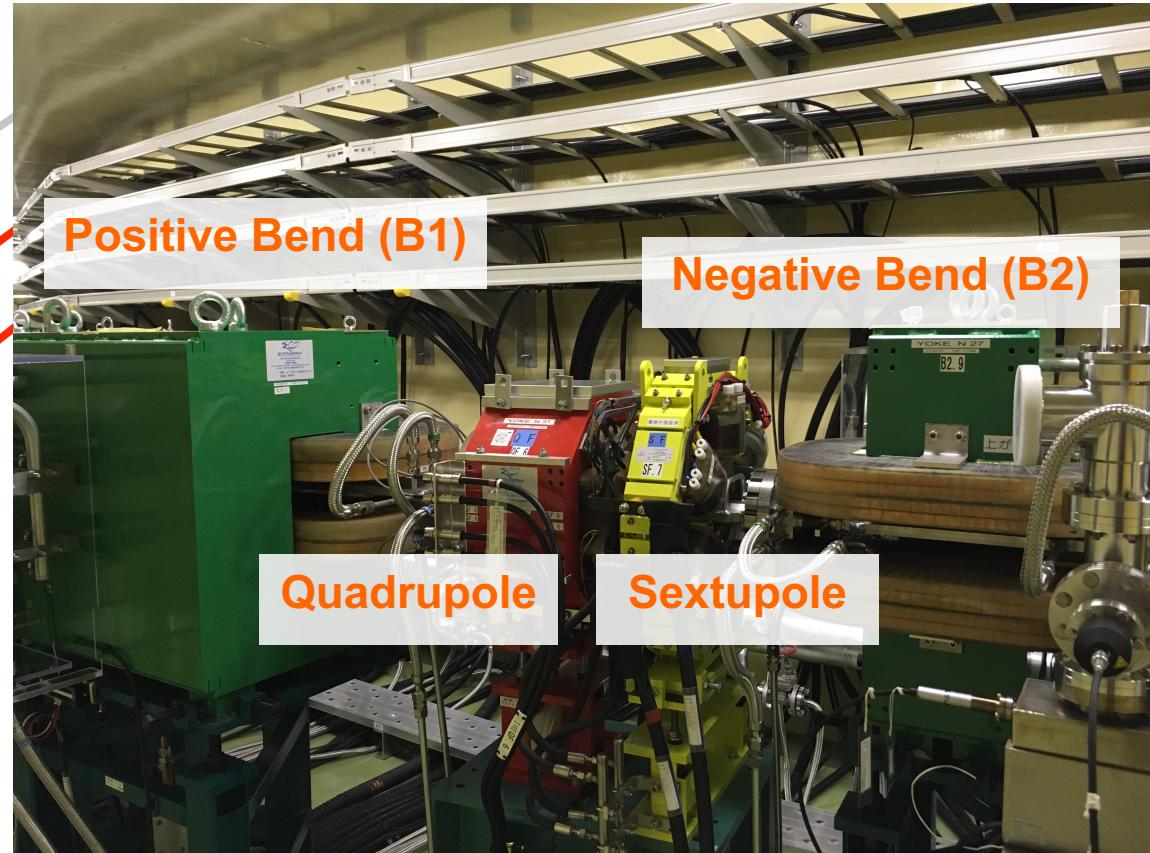
FODO Cell with Negative Bend

Radiation Damping Timeを短くするため、Negative Bendを採用した(M. Kikuchi)



- B1 : Positive Bend (angle >0)
- B2 : Negative Bend (angle <0)

Dipole field ~ 1.3 T



DR Parameters

Parameters	New Model	Unit
Energy	1.1	GeV
Circumference	135.498295	m
# of bunch	2	
# of bunch / train	2	
Max. stored current	11	mA
Energy loss per turn	0.0847	MV
Damping time ($\tau_x / \tau_y / \tau_z$)	11.5 / 11.7 / 5.8	msec
Emittance ($\varepsilon_x / \varepsilon_y / \varepsilon_z$)	29.2 / 1.5 / 3630	nm
$\varepsilon_y / \varepsilon_x$	5	%
$v_x / v_y / v_s$	8.830 / 6.280 / -0.018	
Energy spread	0.055	%
Bunch length	6.6	mm
Mom. Comp. factor	0.0100	
# of cells	32	
Total RF voltage	1.0	MV
RF frequency	509	MHz
Bucket Height	1.5	%

$$\gamma\varepsilon_x/\gamma\varepsilon_x (\mu\text{m}) = 64.3/3.2$$

	DRへの入射	DR設計値
$\gamma\varepsilon_x(\mu\text{m})$	2800	64.3
$\gamma\varepsilon_y(\mu\text{m})$	2600	3.2
$\sigma_z(\text{mm})$	$\pm 30^*$	6.6
$\sigma_\delta(\%)$	$\pm 1.5^*$	0.055

1. DR Complex

1. DR complex

- **LTR:** 入射路
 - フラックスコンセントレーター(FC)(MOP063, Y. Enomoto, 他)からの陽電子は進行方向に 巨大な広がりがある。ロスに注意！
 - DRのエネルギーアクセプタンス1.5%以内に納めるため、LTRでは入射ビームのエネルギー広がりを小さくしなければならない。→ Energy Compression System(ECS)
 - $R_{56} = -0.6 \text{ m}$, $V_c = 41 \text{ MV}$
- **RTL:** 出射路
 - DRで 小さくなったエミッタンスを増大させずに、下流まで輸送する。
 - DRからのバンチ長は6.6mmと長いので、LINACのS-bandに乗せるために短くしなければならない。→ Bunch Compression System(BCS)
 - $R_{56} = -1.05 \text{ m}$, $V_c = 21.5 \text{ MV}$

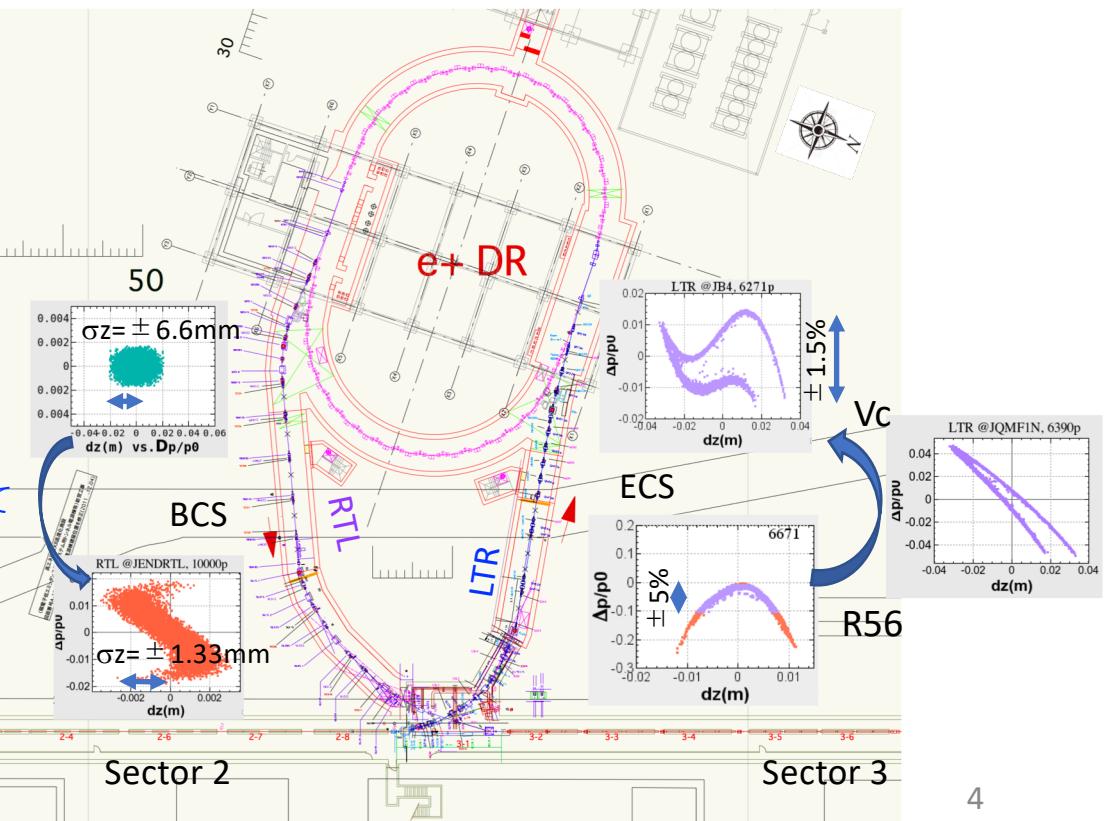
	DRへの入射	DR 設計値
$\gamma\varepsilon_x(\mu\text{m})$	2800	64.3
$\gamma\varepsilon_y(\mu\text{m})$	2600	3.2
$\sigma_z(\text{mm})$	$\pm 30^*$	6.6
$\sigma_\delta(\%)$	$\pm 1.5^*$	0.055

* Full width

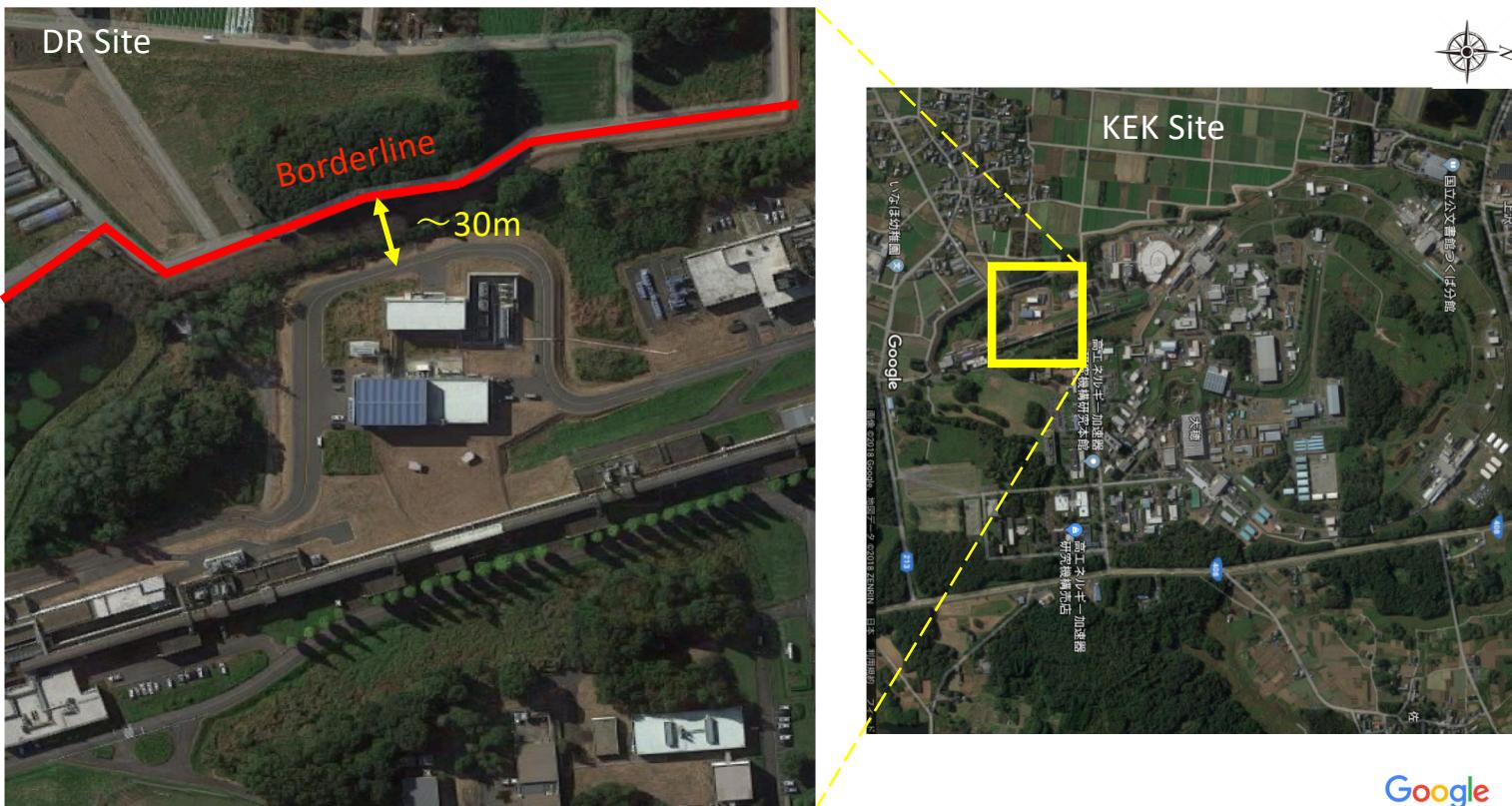
エネルギー広がりやバンチ長はECSやBCSの S-bandに比べて大きいため、サイン形が見えて いる。

陽電子ターゲット+FC

Sector 1



Site of the DR



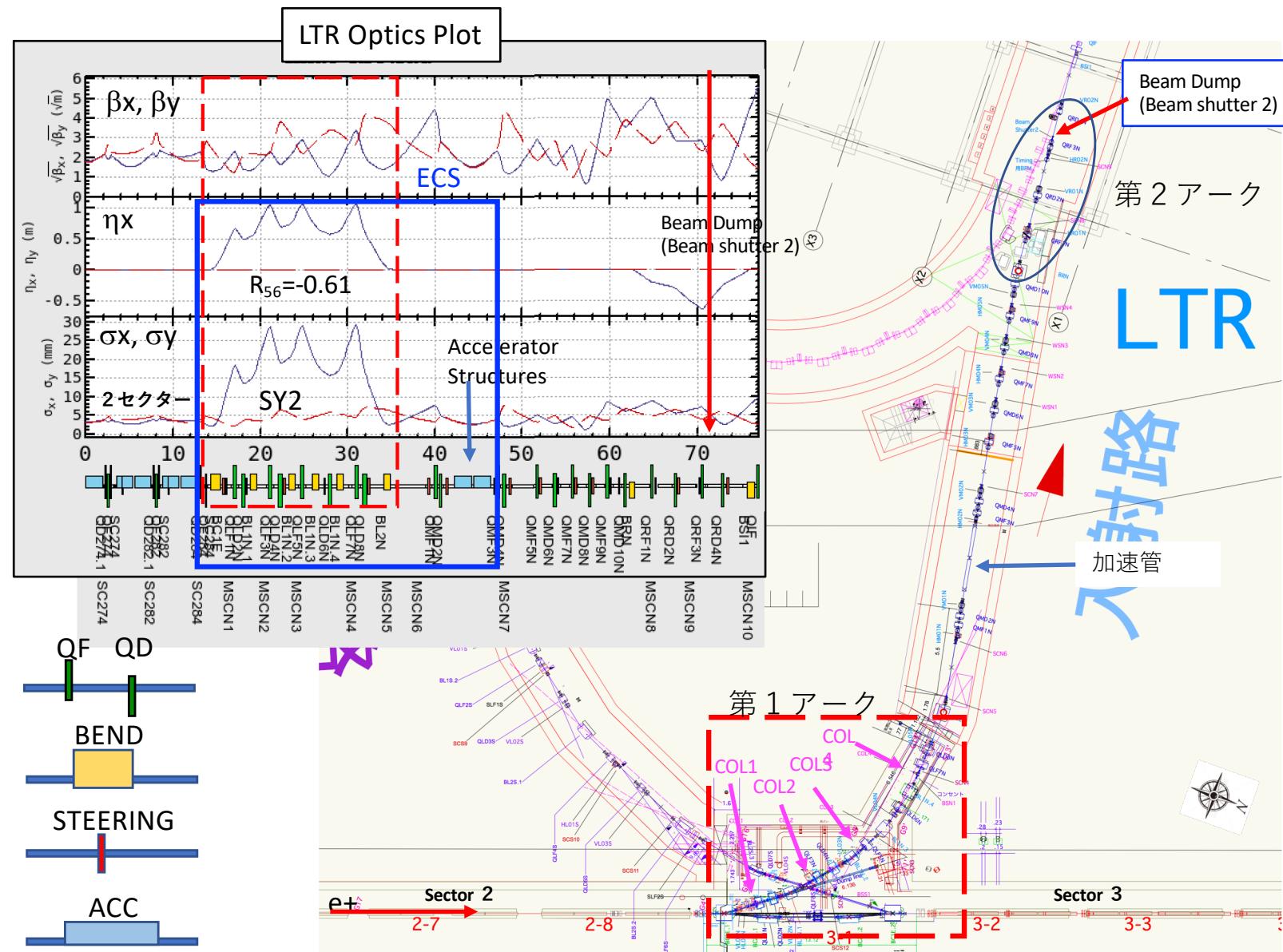
DRはKEKの敷地境界に近い。

2. LTRのコミッショニング

- 2018年1月23日
 - LTRコミッショニング開始
 - 1月24日には、LTR終端までビームが到達した。
- 当初はFCなしの0.75nC/bunchで運転
- DRはKEKの境界領域に近いため、ビームロスは
低く抑えなければならない。

ロスに注意！
- LTR調整
- LTR、RTLの電磁石はDRのエネルギーに合わせて
セット

LTR レイアウトと Optics



2. LTRコミッショニング

LTR 調整

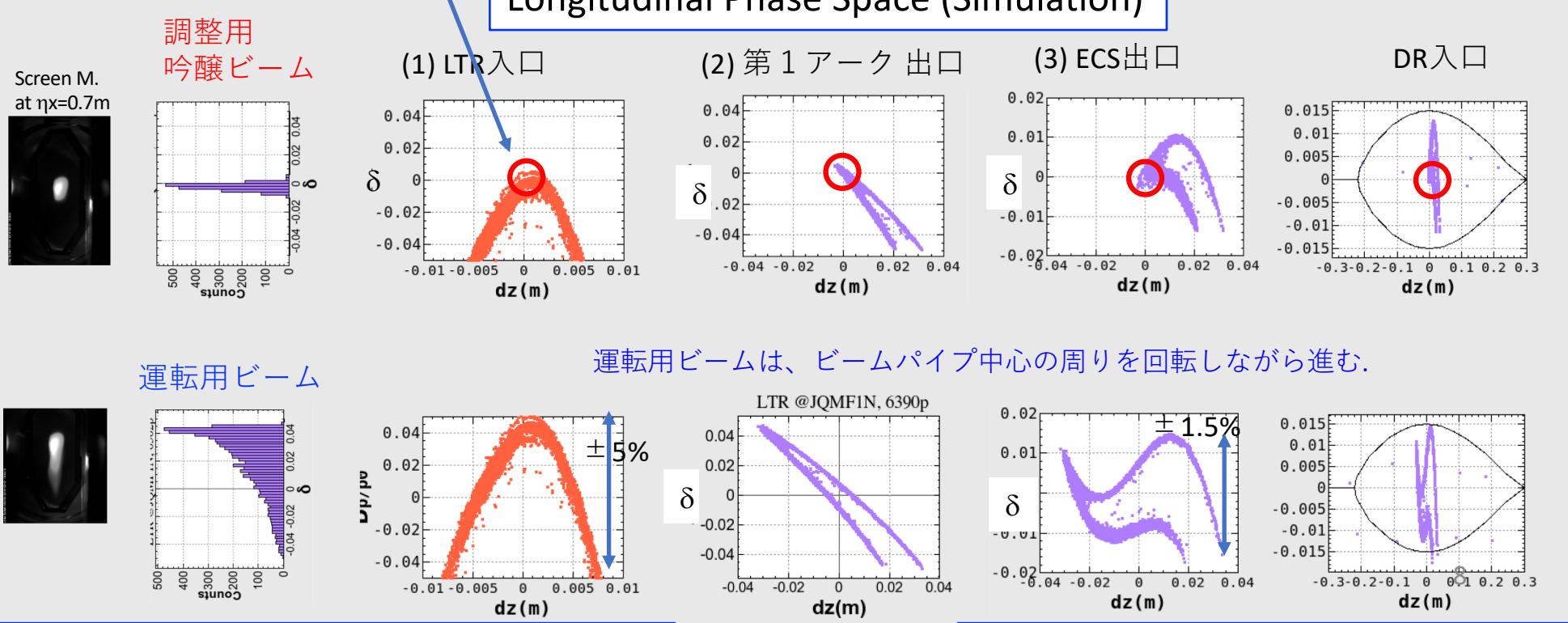
精米歩合60%?

久保田「百寿」

1. 吟釀（コア）ビームを作つて調整
 - 吟釀ビームは、第一アーク内のコリメーターで、“磨く”。
 - ECS Offで、そのビームがビームパイプの真ん中を通るように調整
 - 吟釀ビームでECSの位相調整をする（ゼロクロスを探す）
 2. DR入射調整も、吟釀ビームを使って行う。
 - 飽くまで、進行方向位相空間中心で合わせる。
 3. コリメーターを開ける
 4. 最後に、運転ビームに戻す。
 5. これ以降、運転ビームで上記の調整をしてはならない。



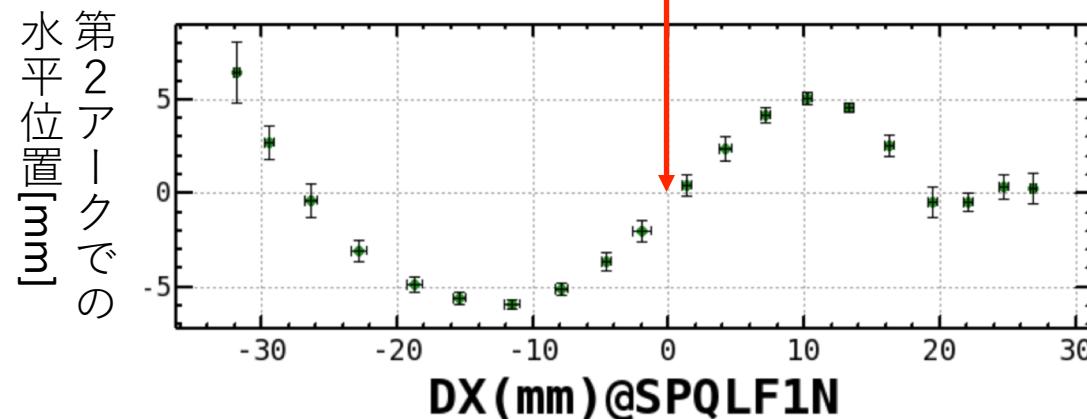
Longitudinal Phase Space (Simulation)



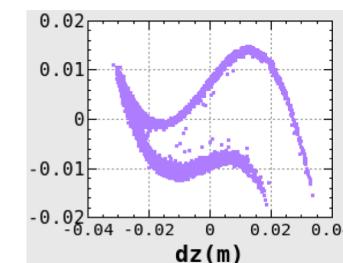
吟醸ビームでECS調整

Y. Seimiya, N. Iida

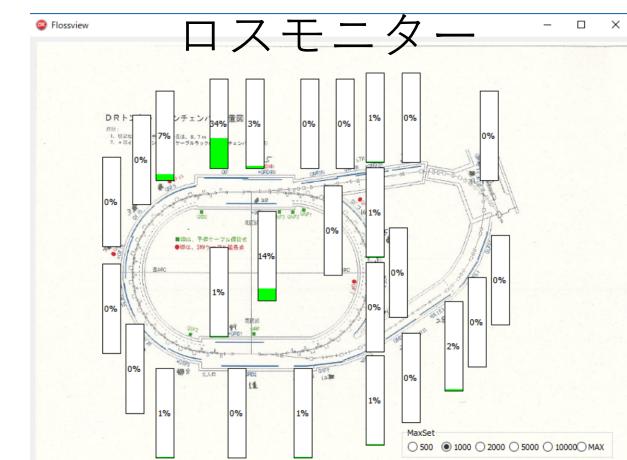
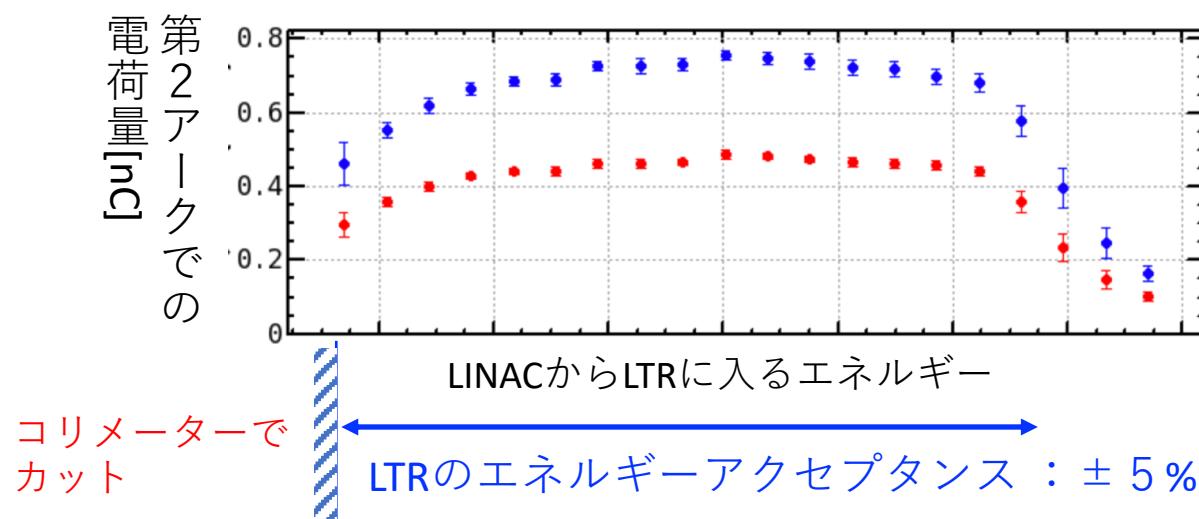
ECS加速管のゼロクロス



通常のECSだと、
真横になるが、



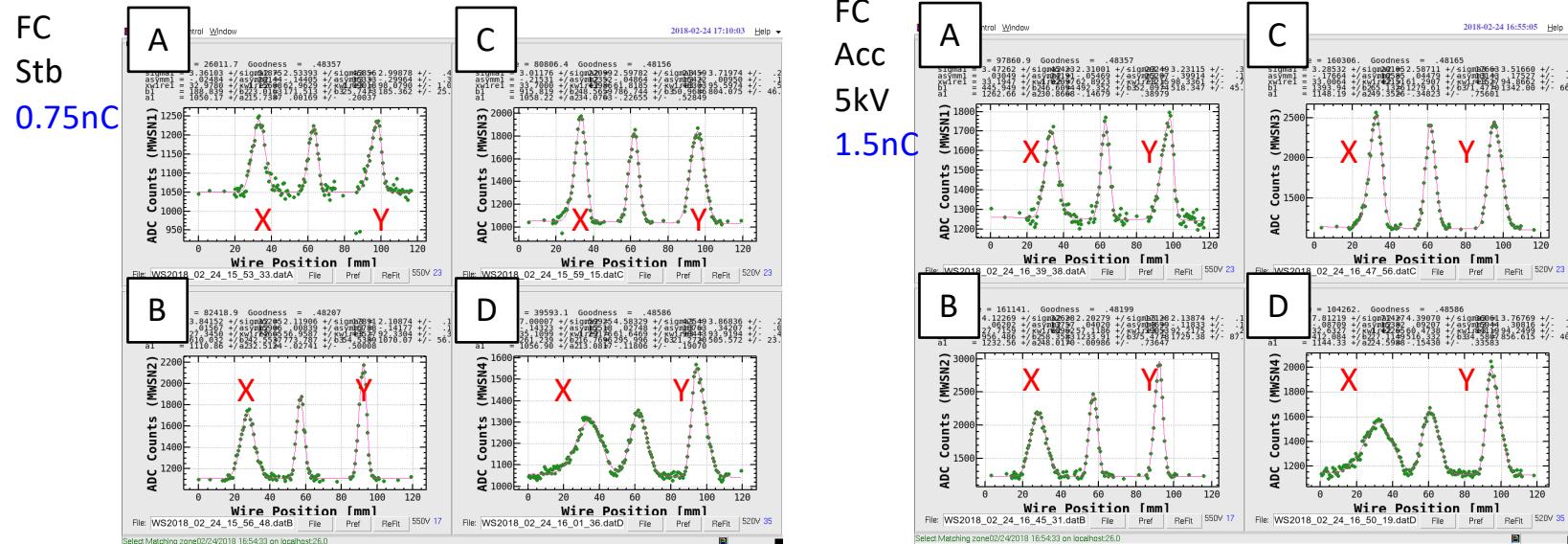
S-bandのカーブがあるが、
±1.5%以内に収めるため、
傾きをつけた



ビームロスは問題なく通せた

LTRのワイヤースキャナー(WS)でエミッタスを測定

4台1組(ABCD)のワイヤースキャナーをLTR直線部に設置、ビームサイズ測定に使用。

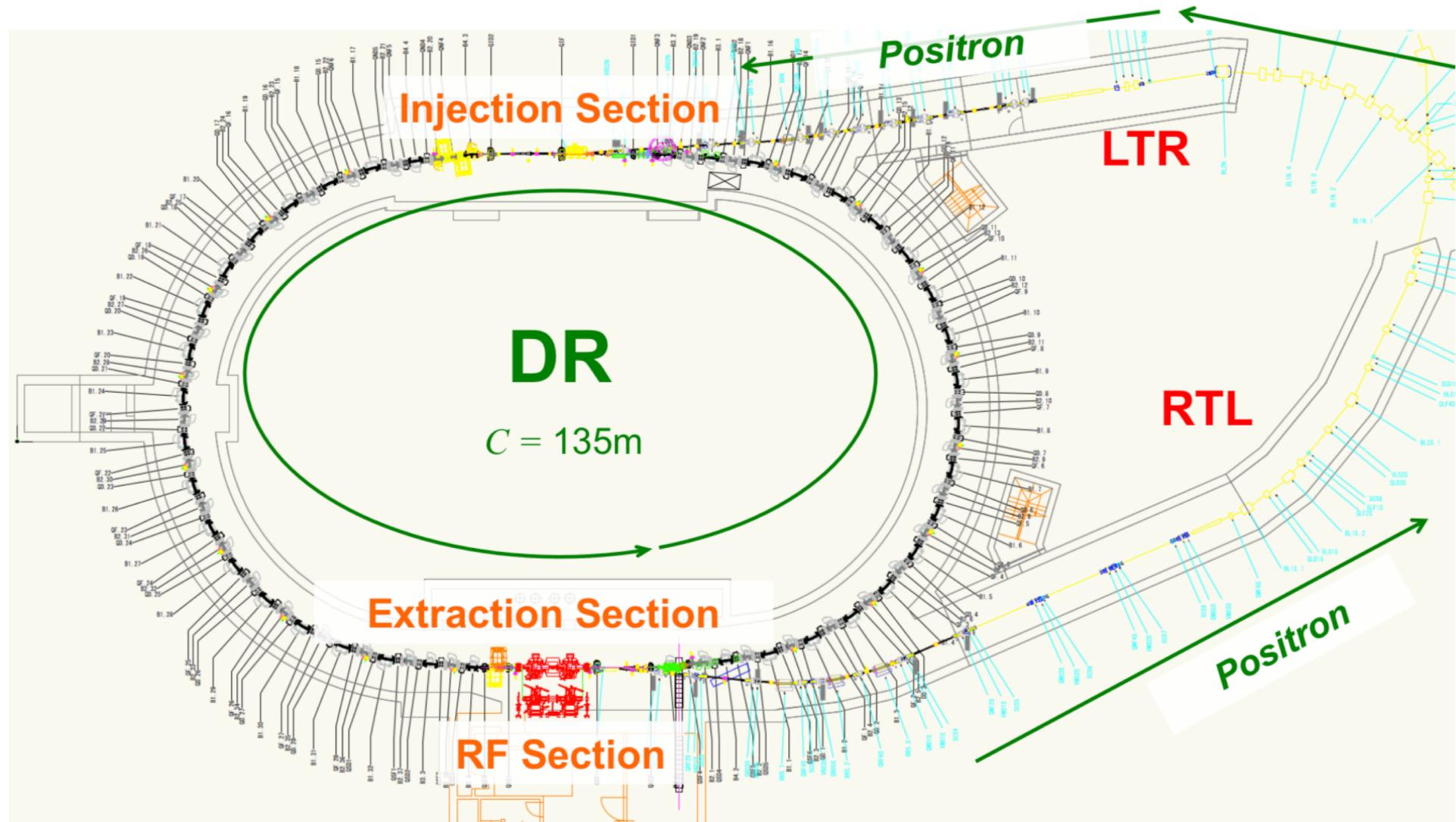


4nC		
設計値	入射路	出射
$\gamma\varepsilon_x(\mu\text{m})$	2800	89.3
$\gamma\varepsilon_y(\mu\text{m})$	2600	4.5
$\sigma_z(\text{mm})$	$\pm 30^*$	6.6
$\sigma_\delta(\%)$	$\pm 1.5^*$	0.055

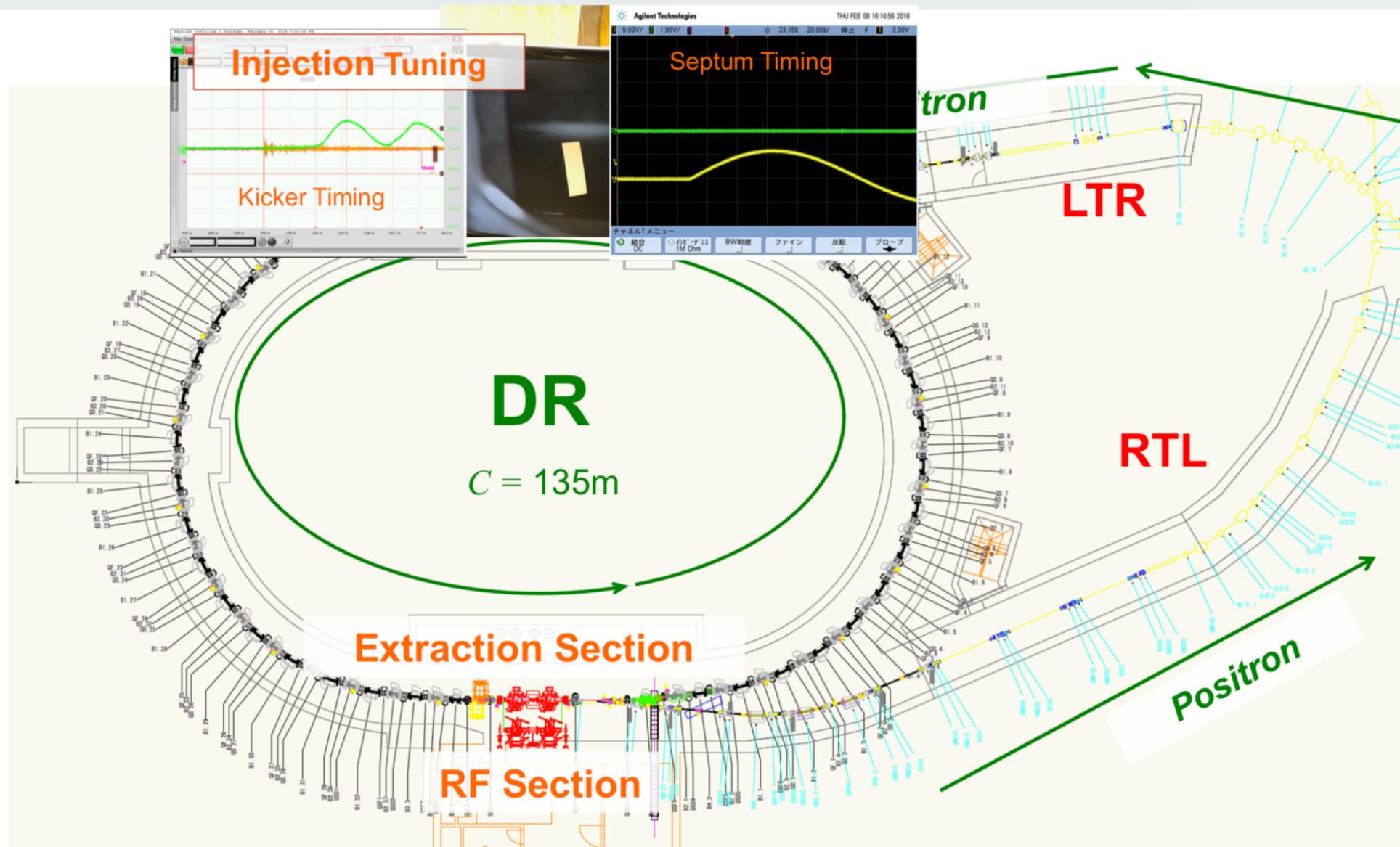
測定値	0.75nC	1.5nC
	FC : Stand-by	FC : 5kV
$\gamma\varepsilon_x [\mu\text{m}]$	2350	2760
$\gamma\varepsilon_y [\mu\text{m}]$	2310	2450
BMAGx	1.58	1.53
BMAGy	1.00	1.01

FCのOn/Offで、測定されたエミッタスに大きな違いはなかった。

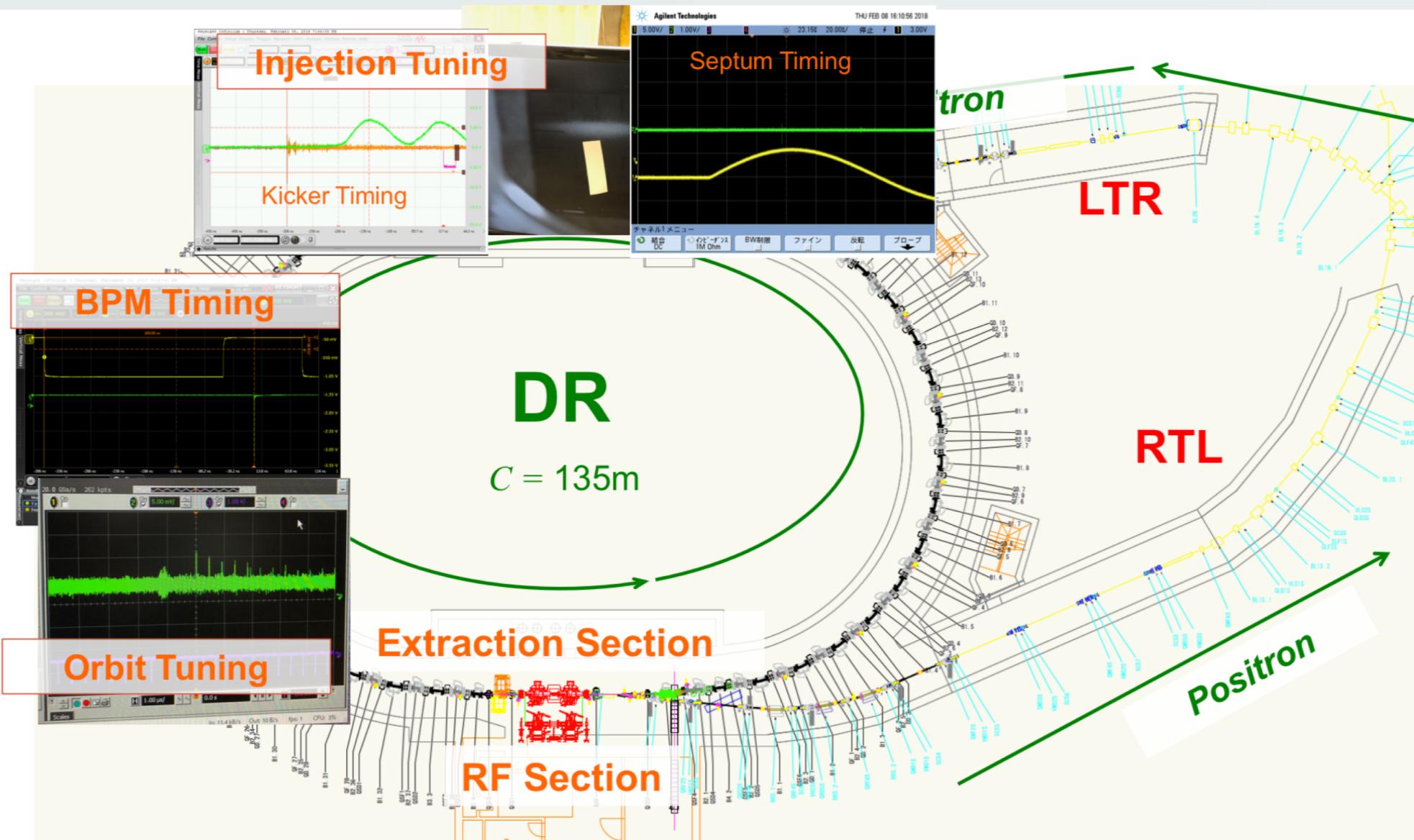
The First 3 Days



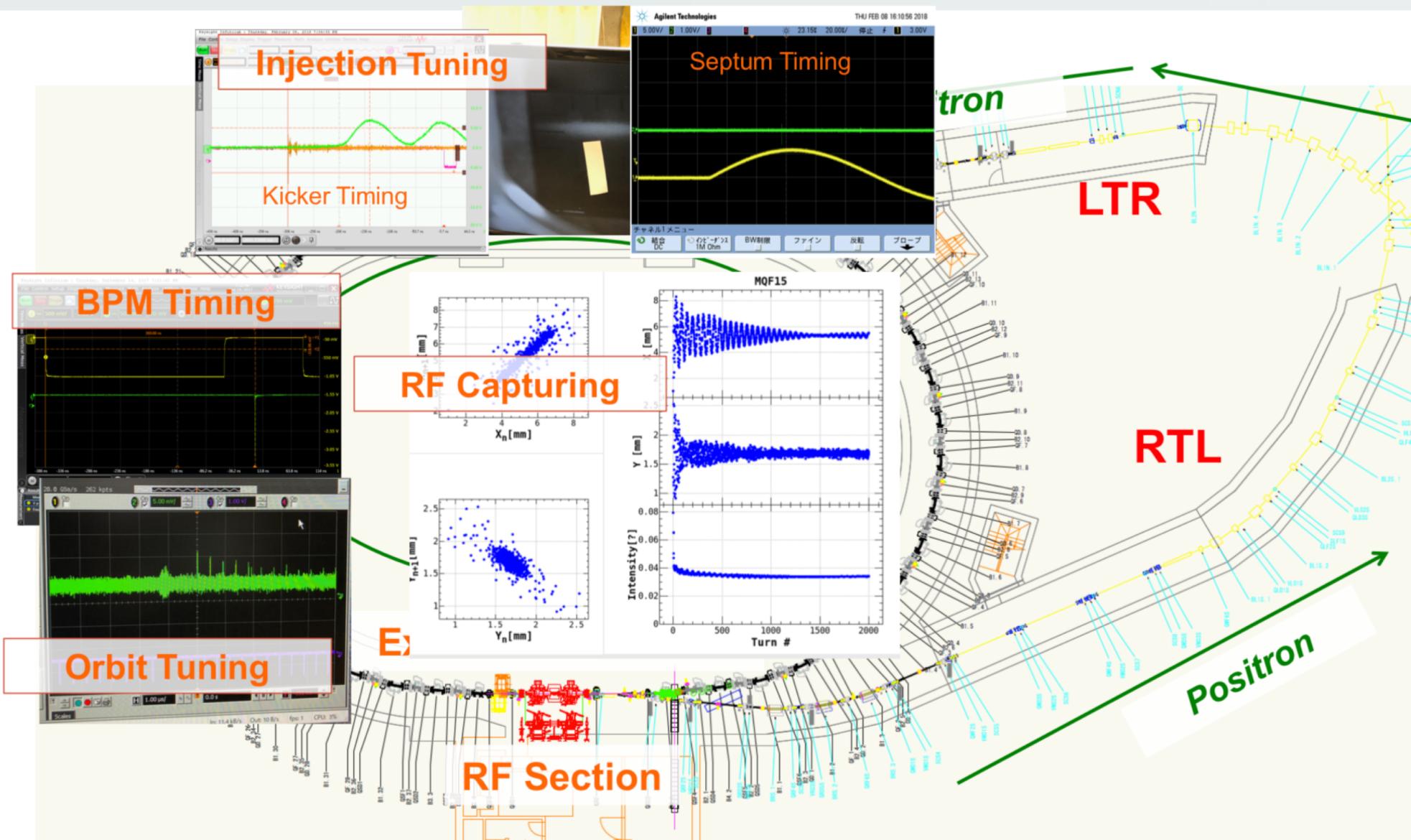
The First 3 Days



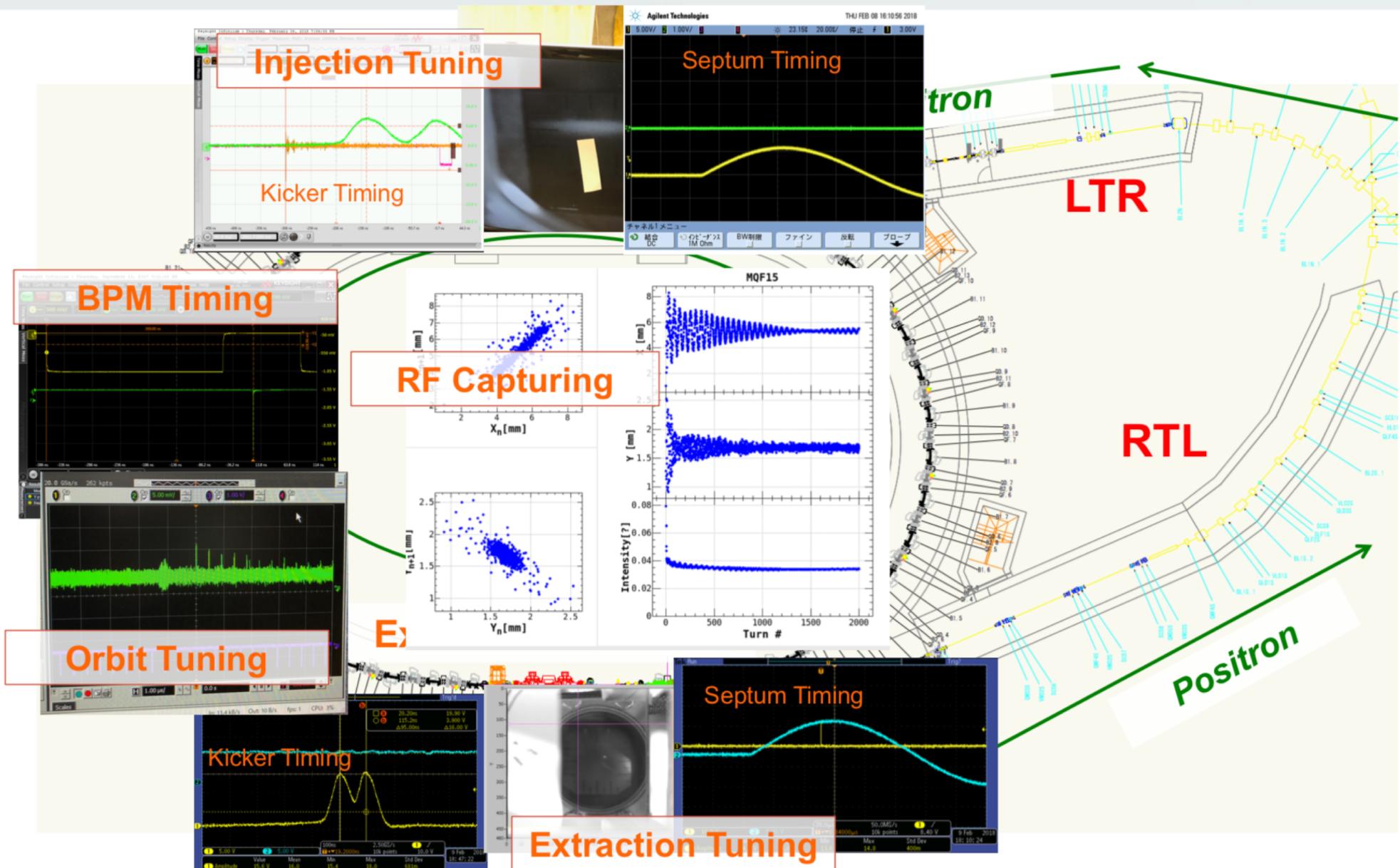
The First 3 Days



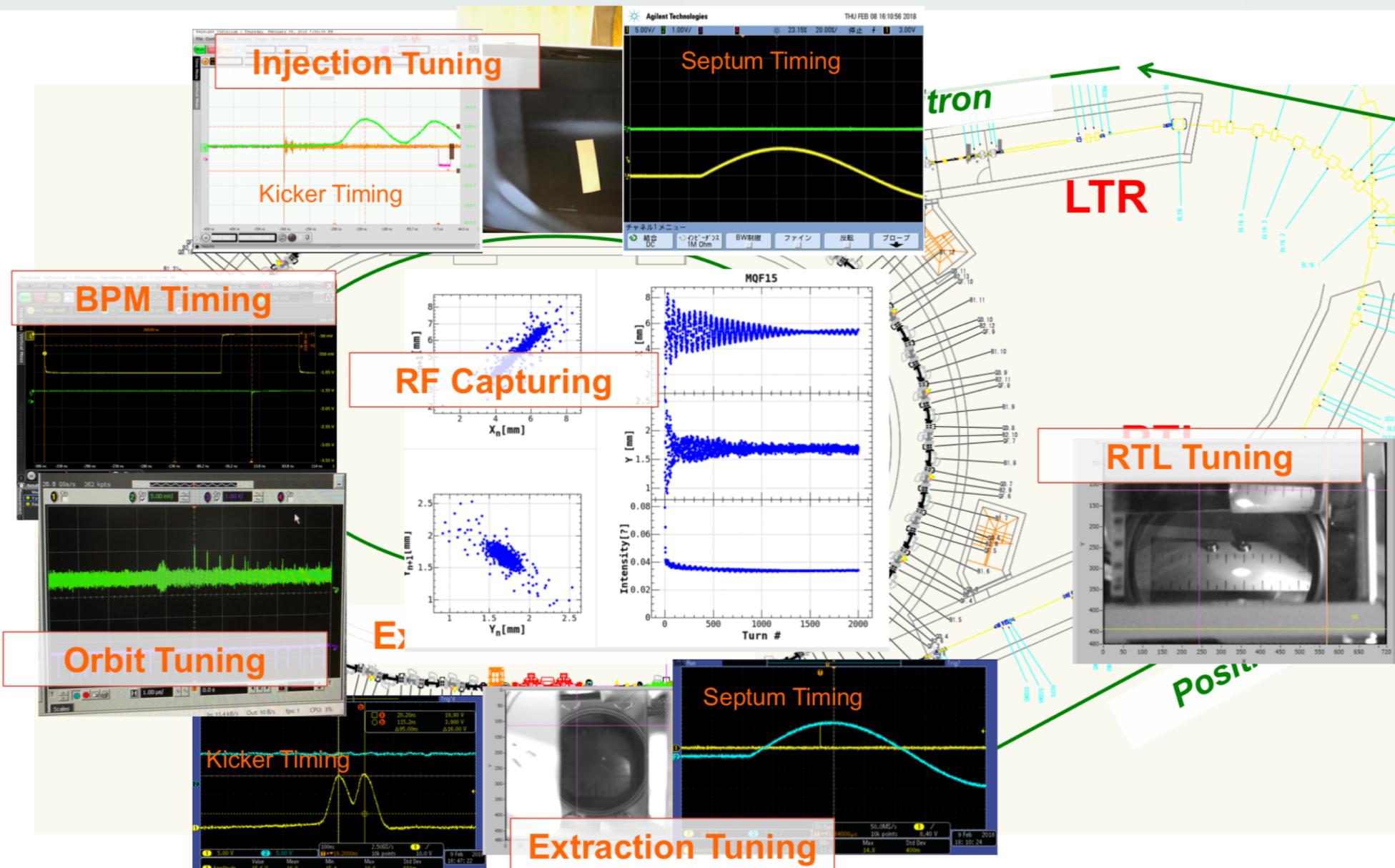
The First 3 Days



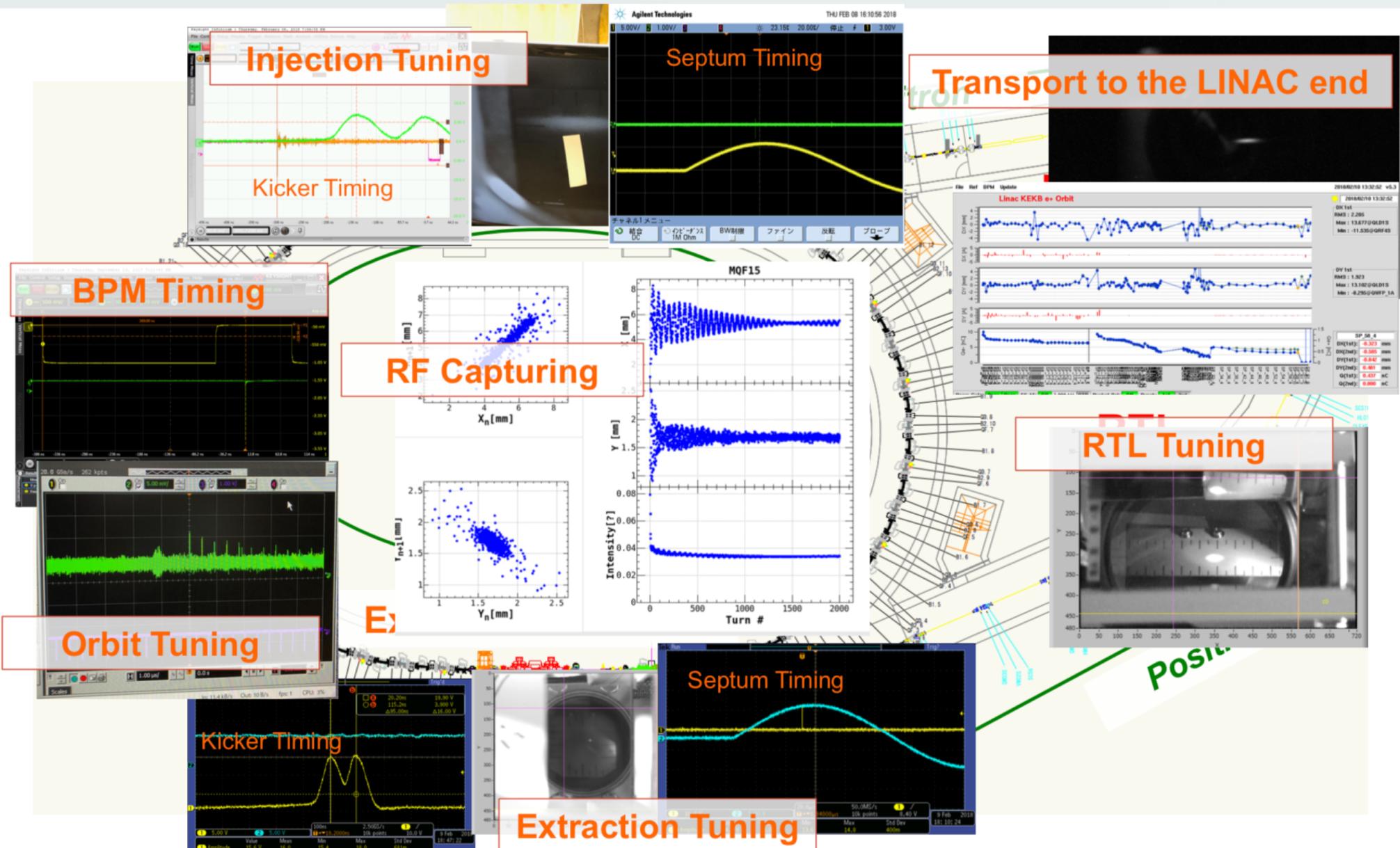
The First 3 Days



The First 3 Days



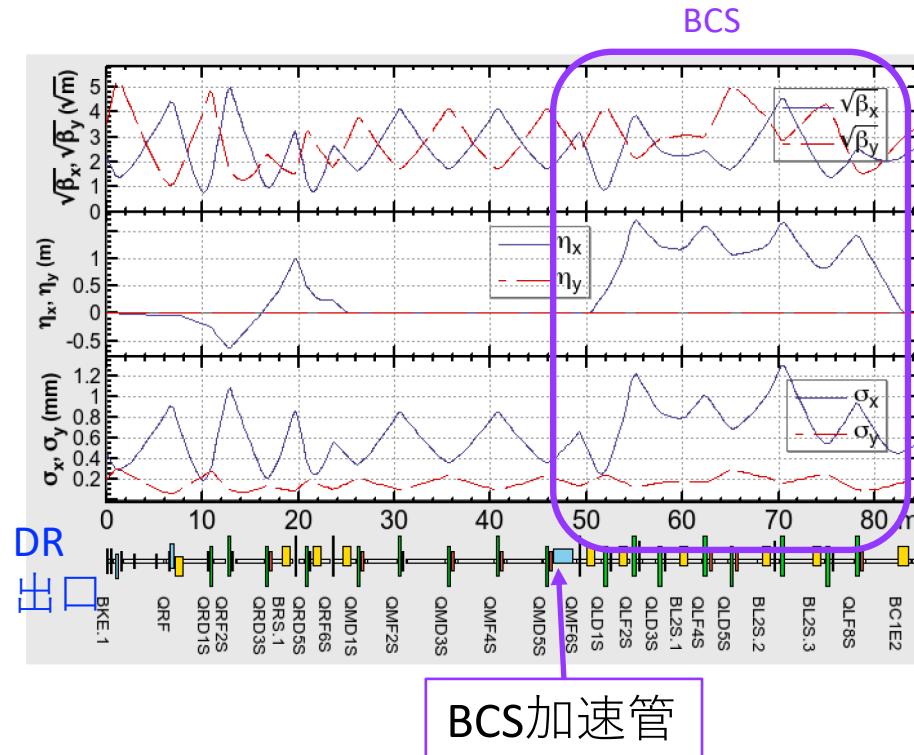
The First 3 Days



3. RTLのコミッショニング

低エミッタンスを保持して輸送

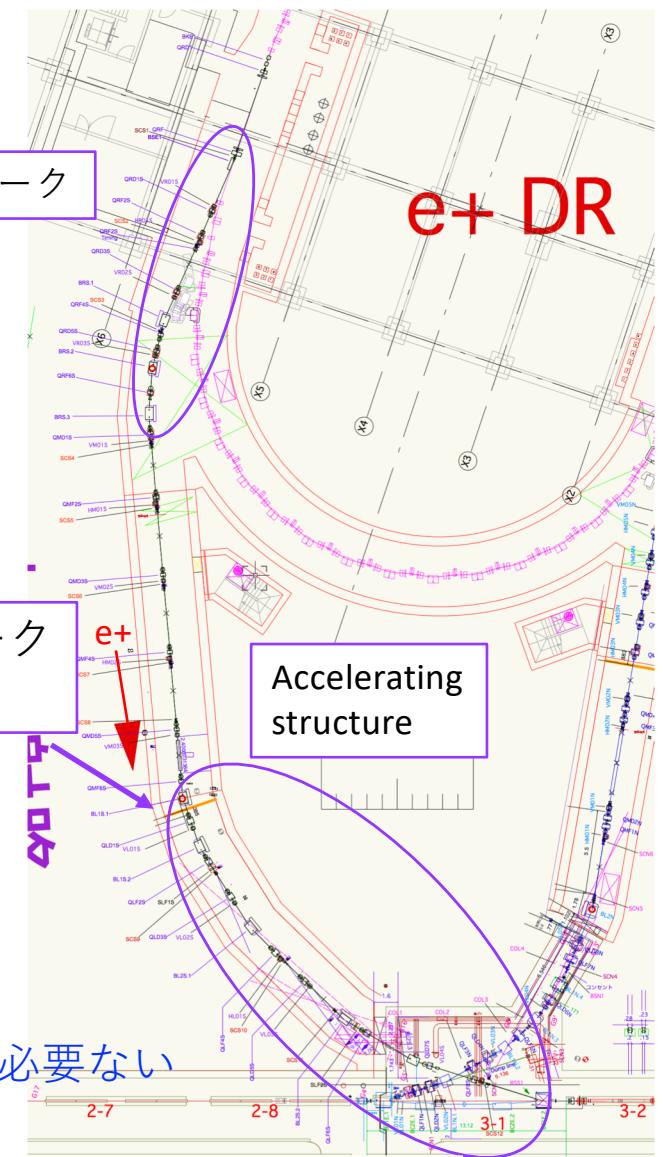
RTL 調整



第1アーク

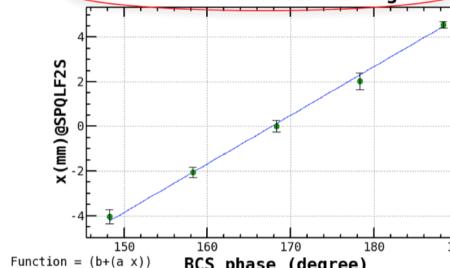
第2アーク
 $R_{56}=-1.05$

LINACへ
戻り



ChiSquare = 1.37809 Goodness = .71068
 $a = .21795 \pm .01041$ $b = 36.540 \pm 1.82131$

ZeroCross=167.6±3.81 degree



リングからのビームはきれいなガウシアンなので、吟釀ビームは必要ない

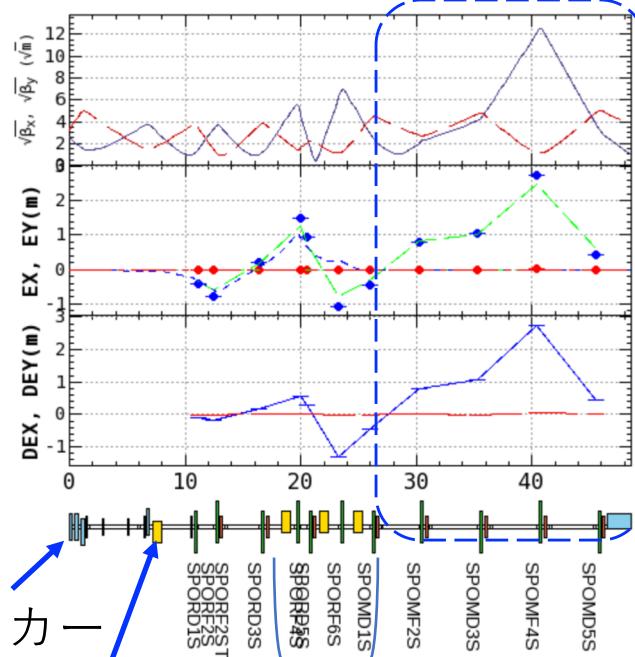
1. 軌道調整は、BCS 加速管を Stand-by にして行う
2. BCS 加速管のゼロクロスを測定。
3. 0か、πかは、LINAC下流の水平Dispersionのある場所で判定。

各アーク部のDispersion補正

低エミッタンスの保持には、各アークでDispersionが閉じてないといけない。

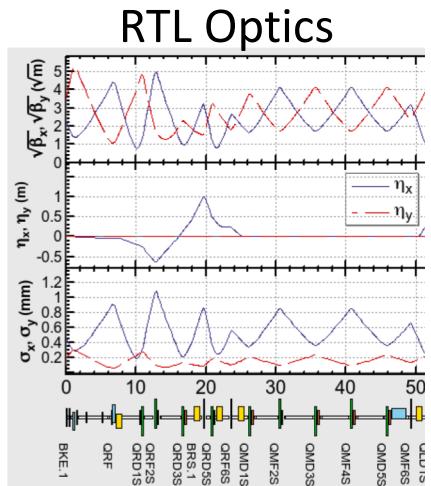
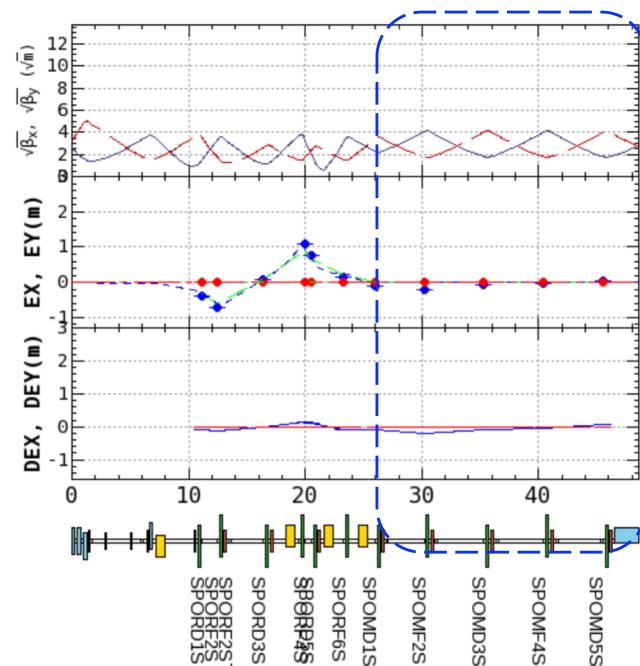
	< η_x > [m]		< η_y > [m]		QuadのFudge Factor
Correction	Before	After	Before	After	[%]
LTR第1アーク	0.037	0.018	0.019	0.016	-3.3, -2.4
RTL第2アーク	0.079	0.019	0.0094	0.0077	-4.5
RTL第1アーク	1.05	0.09	0.02	0.01	-8.2

例：RTL第1アーク 補正前 要検討 補正後 Y. Seimiya



出射キッカ

出射セプタム DC Bends

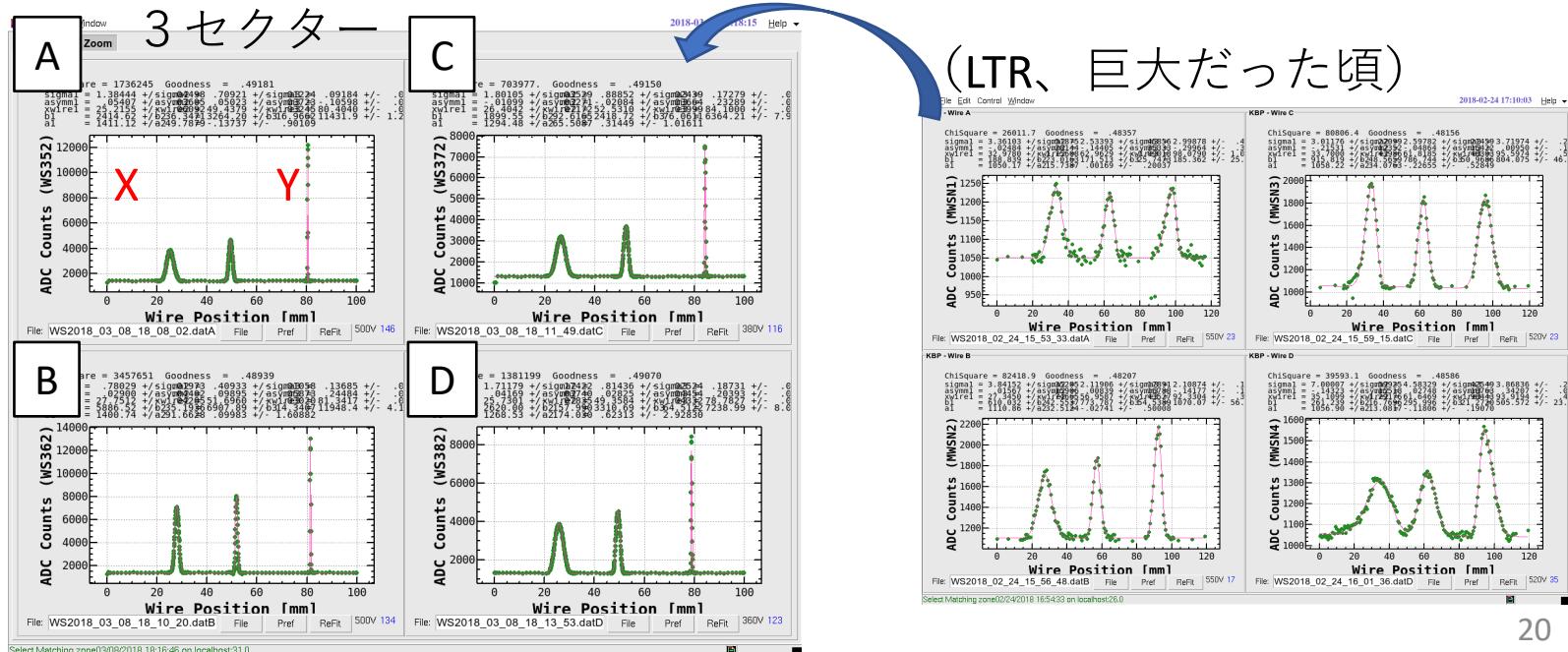


DRのエネルギーを変える代わりに、Bend、Quadの強さを一斉に変えた。
キッカ、セプタムについてはResponse測定を行った。

3セクターのワイヤースキヤナーで エミッタンスを測定

0.7 [nC]	Sector 3		DR(Optics Calculation)
	補正前	第2アーク 補正後	第1アーク 補正後
$\gamma\epsilon_x$ [μm]	293 ± 44.5	192 ± 22.4	126 ± 8.2
$\gamma\epsilon_y$ [μm]	1.84 ± 0.163	2.01 ± 0.363	1.5 ± 0.1

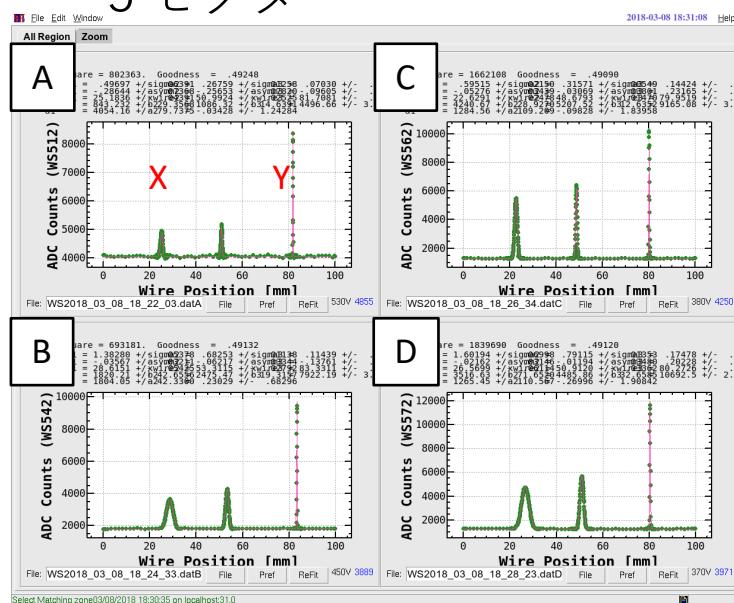
水平Dispersionは半分以下に。
DRのXY Couplingは2.3%以下と推定される。



5セクターのワイヤースキャナーで エミッタンスを測定

5

セクター

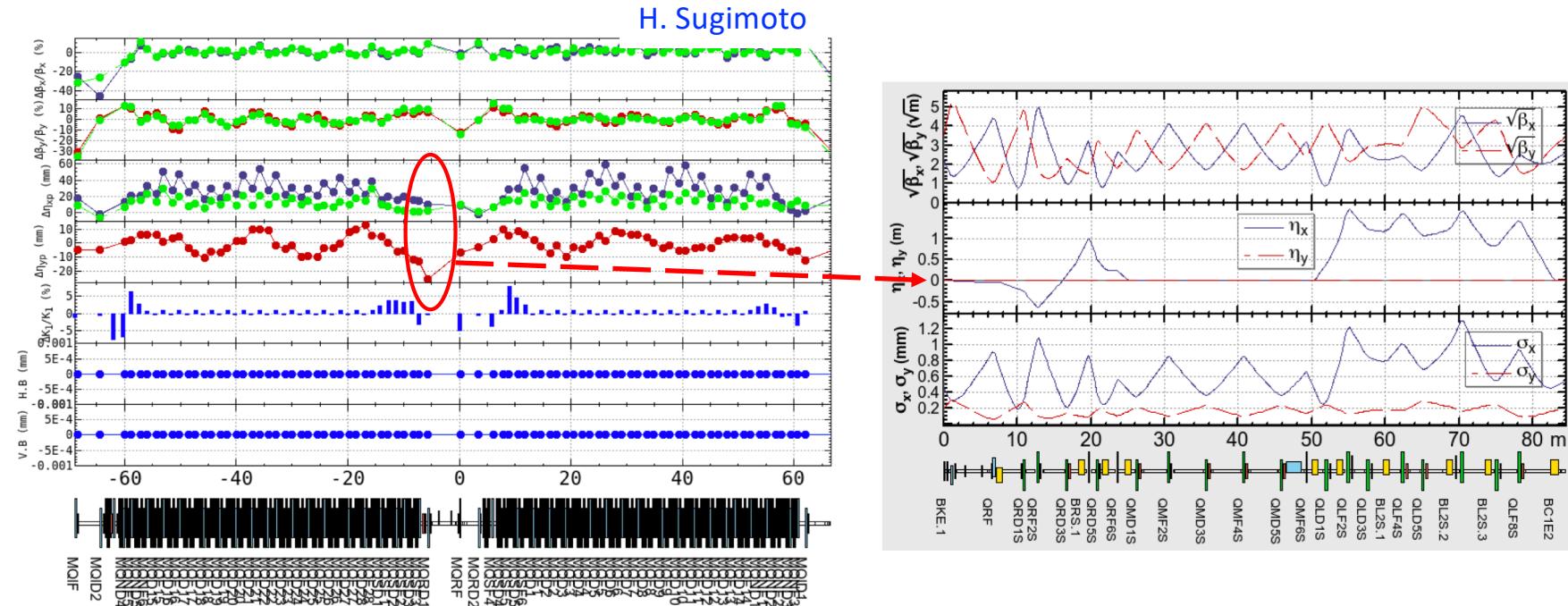


0.7 [nC]	wsによる測定値		SuperKEKB-LER からの要求値	
	Sector 3	Sector 5	Phase-2	Phase-3
$\gamma \epsilon_x (\mu\text{m})$	126 ± 8.2	189 ± 64	< 200	< 100
$\gamma \epsilon_y (\mu\text{m})$	1.5 ± 0.1	1.9 ± 0.3	< 40	< 15

DR 設計	入射	出射
$\gamma \epsilon_x (\mu\text{m})$	2800	64.3
$\gamma \epsilon_y (\mu\text{m})$	2600	3.2
$\sigma_z (\text{mm})$	$\pm 30^*$	6.6
$\sigma_\delta (\%)$	$\pm 1.5^*$	0.055

- 3～5セクターでエミッタンス増大が観測されている。
 - Transverse Wake Fieldの問題。
 - Offset 軌道によるWake FieldのCancelを行う予定。
- 水平エミッタンスについては、Phase-3以降のSuperKEKB-LERからの入射ビーム条件が満たされない。

DR内のDispersion測定値からの寄与



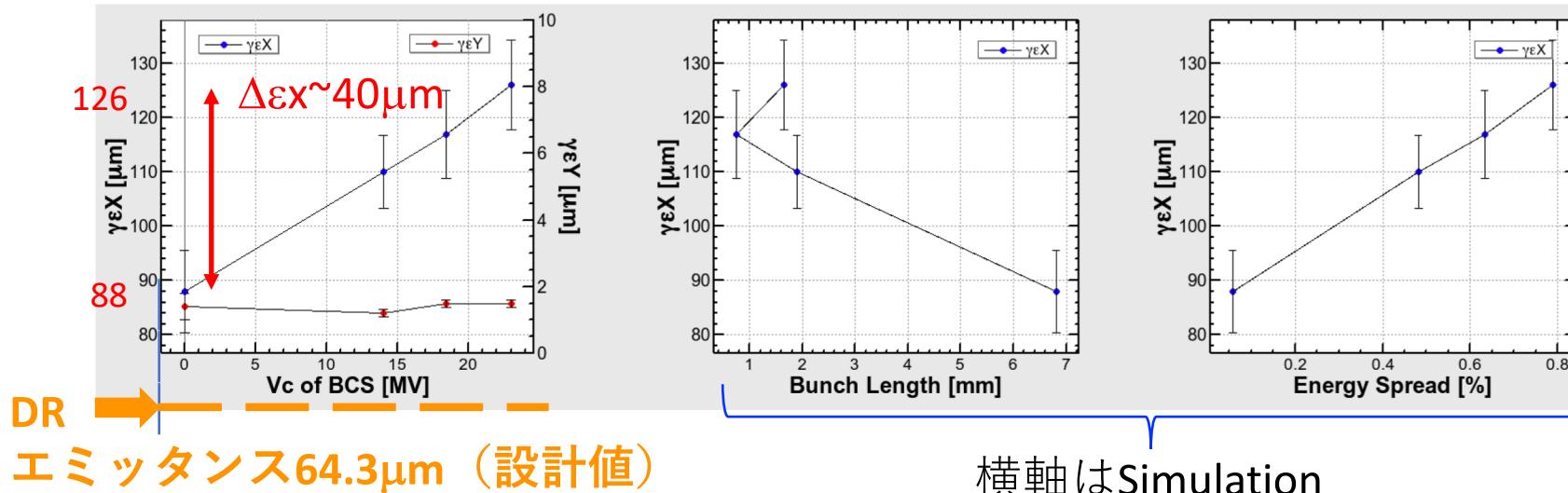
	$\mathcal{H} [\text{m}]$	δ	$\Delta\epsilon [\text{nm}]$	$\Delta\gamma\epsilon [\mu\text{m}]$	$\epsilon [\mu\text{m}]$	$\Delta\epsilon/\epsilon$
X	6.08e-5	5.5e-4	1.84e-2	0.04	64.3 (from DR Optics calculation)	6.2e-4
Y	4.49e-5		1.36e-2	0.03	1.9 (from WS measurement)	1.5e-2

DR出射点で測定された水平DispersionからRTLへのエミッタансの寄与は、
RTLでのエミッタансに対して無視できるほど小さい。

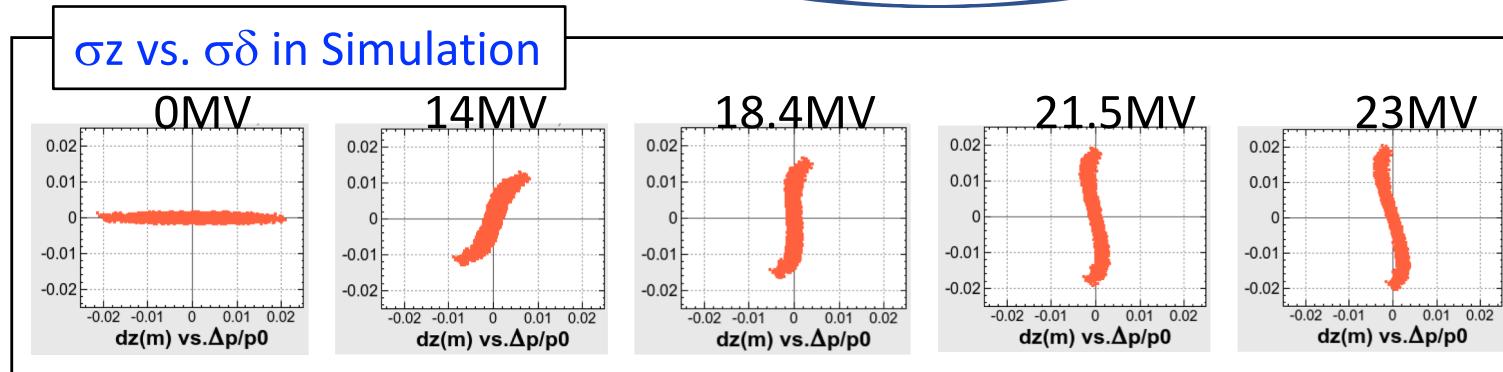
水平エミッタスのBCS-Vc依存測定

0.7nC 3セクターのWire Scanner測定

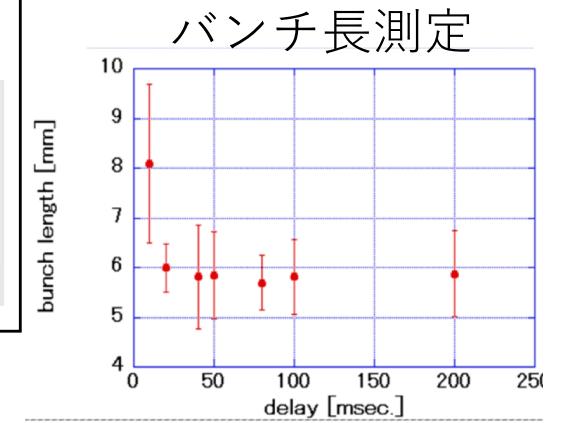
Y. Seimiya, M. Kikuchi, N. Iida



横軸はSimulation



DRからのバンチ長は設計値 (6.6mm)とした。



水平エミッタnsの電荷量依存測定

電荷量 (nC)	加速電圧(MV)	$\gamma\beta\varepsilon_x$ (μm)	$\gamma\beta\varepsilon_y$ (μm)
0.7	0	88 ± 7.6	1.4 ± 0.4
1.5	0	104 ± 7.4	3.7 ± 0.5

- 測定された水平エミッタnsについて
 1. BCSのVc依存性がある。
 - バンチ長：CSR？？
 - 3セクターでのバンチ長測定が必要
 - エネルギー広がり：水平分散の残留漏れ？
 2. 電荷量依存性がある。
 - CSR？？
 - 3セクターTransverse Wake？
 - DRのエミッタns測定が必要

インスタビリティの概算

Handbook of Accelerator Physics and Engineering

CSR

$$Z_{\parallel}(k) = \frac{1}{c} \int_0^{\infty} dz W_{\parallel}(z) e^{-ikz}$$

$$= \frac{Z_0}{2\pi} \frac{e^{I\pi/6}}{3^{1/3}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{k^{1/3}}{R^{2/3}}$$

$$dE = Z(k)L * I/E$$

$$d\varepsilon x = (\eta x * dE)^2 / \beta x$$

$$\Delta\gamma\varepsilon x = \text{Sum} \sum d\varepsilon x i = 0.81 \mu m < 40 \mu m$$

Z0=377
 R=3.35m
 sz=1~7mm
 L=0.7938m
 cc=1nC,
 E=1.1GeV
 I=cc/σz*c
 材質：SUS316L

Resistive wall

$$\frac{Z_m^{\parallel}}{L} = \frac{\omega}{c} = \frac{Z_m^{\perp}}{L}$$

$$= \frac{Z_0 c / (\pi b^{2m})}{[1 + sgn(\omega)i](1 + \delta_{m0})bc \sqrt{\frac{\sigma_c Z_{0c}}{2|\omega|} - \frac{ib^2\omega}{m+1} + \frac{imc^2}{\omega}}}$$

$$\Delta\gamma\varepsilon x = \text{Sum} \sum d\varepsilon x i = 0.0012 \mu m << 40 \mu m$$

いずれも概算では影響は小さそうであるが、さらにCSRのTracking simulationを検討中
 (D. Zhou and Y. Seimiya)

まとめ

- SuperKEKB-LER用陽電子入射ビームのエミッタ
ンスを小さくするためのDRへの入出射コミッ
ショニングを行った。
- 2018年2月、入射(LTR)、出射(RTL)共に順調に立
ち上がり、7月までSuperKEKB-LERに入射した。
- 今後の課題
 - DRから出射路されたビームのエミッタンスは、
SuperKEKB-Phase2(2018年運転)の要求を満たしてい
るが、今後SuperKEKBの性能向上につれて、対策が
必要である。
 - RTLエミッタンス増大の原因については検討中
 - DR内のエミッタンス(ビームサイズ)測定
 - 3セクターでのバンチ長測定
 - (BT下流でのエミッタンス増大)